

2025 年 10 月 3 日

ROHM Co., Ltd.
Infineon Technologies AG

ROHM 與 Infineon 攜手推進 SiC 功率元件封裝相容性 為客戶帶來更高靈活度

半導體製造商 ROHM（總公司：日本京都市）與 Infineon Technologies AG（總公司：德國諾伊比貝格，以下簡稱 Infineon）針對建立 SiC 功率元件封裝合作機制簽署了備忘錄。雙方對應用於車載充電器、太陽能發電、儲能系統及 AI 資料中心等領域的 SiC 功率元件封裝展開合作，推動彼此成為 SiC 功率元件特定封裝的第二供應商。今後客戶可同時從 ROHM 與 Infineon 採購相容封裝的產品，既能靈活滿足客戶的各類應用需求，亦可輕鬆實現產品切換。此次合作將顯著提升客戶在設計與採購的便利性。

Infineon 零碳工業功率事業部總裁 Peter Wawer 表示：「我們很高興能夠與 ROHM 攜手，進一步加速碳化矽功率元件的普及。此次合作將為客戶在設計和採購流程中，提供更豐富的選擇與更大的靈活性，同時還有助開發實現低碳社會的高能效應用方案。」

ROHM 常務執行董事 功率元件事業部負責人 伊野和英表示：「ROHM 的使命是為客戶提供最佳解決方案。與 Infineon 的合作將成為我們實現拓展解決方案組合的一大步。我們期待透過此次合作，能夠在推進協同創新的同時降低複雜性，進一步提升客戶滿意度，共同打造功率電子業界的未來。」



Infineon 零碳工業功率事業部總裁 Peter Wawer（左）

ROHM 常務執行董事 伊野和英（右）

作為此次合作的一部分，ROHM 將採用 Infineon 創新 SiC 頂部散熱平台（包括 TOLT、D-DPAK、Q-DPAK、Q-DPAK Dual 和 H-DPAK 封裝）。該平台將所有封裝統一為 2.3mm 的標準化高度，不僅簡化設計流程、降低散熱系統成本，更能有效利用基板空間，功率密度提升幅度最高可達二倍。

同時 Infineon 將採用 ROHM 的半橋結構 SiC 模組「DOT-247」，並開發相容封裝。這將使 Infineon 新發佈的 Double TO-247 IGBT 產品組合新增 SiC 半橋解決方案。ROHM 的 DOT-247 先進封裝相比傳統 Discrete 元件封裝，將可實現更高功率密度與設計自由度。DOT-247 採用將二個 TO-247 封裝相連的獨特

結構，比 TO-247 封裝降低約 15%的熱阻和 50%的電感。憑藉上述特性，該封裝的功率密度達到 TO-247 封裝的 2.3 倍。

ROHM 與 Infineon 計畫不僅在矽基封裝，今後還將在 SiC、GaN 等各封裝進一步擴大合作。此舉也將進一步深化雙方的合作關係，為客戶提供更廣泛的解決方案與採購選擇。

SiC 功率元件透過更高效的電力轉換，不僅增強了高功率應用的性能表現，在嚴苛環境下展現出卓越的可靠性與耐用性，同時亦有助應用實現小型化。借助 ROHM 與 Infineon 的 SiC 功率元件，客戶可為電動車充電、可再生能源系統、AI 資料中心等應用開發高效解決方案，實現更高功率密度。

關於 Infineon

Infineon 是全球功率系統和物聯網領域的半導體領導者。Infineon 以其產品和解決方案推動低碳化和數位化。該公司在全球擁有約 58,060 名員工（截至 2024 年 9 月底），在 2024 年度（截至 9 月 30 日）的營收約 150 億歐元。Infineon 在法蘭克福證券交易所上市（股票代碼：IFX），在美國的 OTCQX 國際場外交易市場上市（股票代碼：IFNNY）。如欲瞭解詳情，請至 <https://www.infineon.com/>。